



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(52) СПК
G01N 27/12 (2020.02)

(21)(22) Заявка: 2019144277, 27.12.2019

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
27.12.2019

Дата регистрации:
22.06.2020

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 27.12.2019

(45) Опубликовано: 22.06.2020 Бюл. № 18

Адрес для переписки:

644050, г. Омск, пр-кт Мира, 11, ОмГТУ,
Информационно-патентный отдел, Бабенко
О.И.

(72) Автор(ы):

Кировская Ираида Алексеевна (RU),
Миронова Елена Валерьевна (RU),
Уманский Илья Юрьевич (RU),
Эккерт Алиса Олеговна (RU),
Эккерт Роберт Владимирович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Омский государственный
технический университет"(ОмГТУ) (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2106621 C1, 10.03.1998. RU
2561019 C1, 20.08.2015. RU 8122 U1, 16.10.1998.
RU 2305830 C1, 10.09.2007. RU 118438 U1,
20.07.2012. WO 2009024774 A1, 26.02.2009. US
20080110241 A1, 15.05.2008. US 9212055 B2,
15.12.2015. CN 109856197 A, 07.06.2019. CN
105842287 B, 01.01.2019.

(54) Газоанализатор диоксида азота

(57) Формула изобретения

Полупроводниковый датчик диоксида азота, содержащий полупроводниковое основание, нанесенное на непроводящую подложку, отличающийся тем, что полупроводниковое основание выполнено из поликристаллической пленки твердого раствора состава $(\text{InAs})_{0,015}(\text{ZnS})_{0,985}$.

RU 2 724 290 C1

RU 2 724 290 C1